



地方独立行政法人山口県産業技術センターは、「ものづくりのパートナー、もっと迅速に、もっと地域貢献」をスローガンに、当センターの長い歴史の中で積み上げてきた県内企業等との信頼関係や技術ポテンシャルを活かしながら、県内企業等の「中核的技術支援拠点」として、地域経済の持続的発展に寄与してまいります。
 県内企業の研究開発・商品開発等の技術支援を推進するとともに、研修室・会議室などの施設や、200以上の試験研究・分析装置を開放しています。

フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡

日本電子株式会社 JAMP-9500F

酸化皮膜等の極表面（表面から数 nm の深さまで）の分析およびイオンスパッタリング法による深さ方向の元素組成の変化（デプスプロファイル）を測定します。

- 電子銃：ショットキーフィールドエミッション電子銃
- 加速電圧：0.5 ~ 30kV ● 倍率：×25 ~ 500,000 ● 二次電子像分解能：3nm (25 kV、10pA)
- オージェ分析時のプローブ径：8nm (25kV、1nA)
- ◆ **オージェ電子分光系**
- アナライザ：同心半球形静電アナライザ (HSA) ● 分析エネルギー範囲：0 ~ 2,500eV
- エネルギー分解能：(ΔE/E) 0.05 ~ 0.6 %
- ◆ **試料ステージ**
- 駆動範囲：X：±10mm、Y：±10mm、Z：±6mm
 T：0 ~ 90°、R：360°（制限なし）
- 試料サイズ：最大 20mmφ × 5mmH



レーザー干渉平面度測定装置

株式会社ニデック FT-900v2

シリコンウエハの平面度測定や成膜プロセスの応力解析に利用できるほか、高精度加工部品の平面度の測定ができます。

- 測定方式：斜入射光波干渉方式
- 測定範囲：φ200mm 以下
- 保持具：ウエハ用全面吸着チャック (2,4,6インチ)、ウエハ用中心吸着チャック (2,4,6インチ)
 任意形状サンプル保持台
- 干渉縞解析ソフト：ウエハ解析、サイト解析、任意形状サンプルの平面度解析、ウエハ用ストレス解析



干渉膜厚計

大塚電子株式会社 FE-3000YIT

半導体や光学材料などの多層膜の絶対反射率・多層膜解析・膜物性解析（n: 屈折率、k: 消衰係数）の測定を行います。

紫外から近赤外域の反射光により、多層膜の膜厚測定・光学定数解析が可能です。

- 測定レンジ：1nm ~ 40 μm ● 測定波長範囲：190nm ~ 1100nm
- 検出器：電子冷却型フォトダイオードアレイ 512ch
 電子冷却型 CCD エリアイメージセンサ 512ch
- 光源：D2/I2 (紫外・可視仕様) D2 (紫外仕様) I2 (可視仕様)
- 測定対象：LCD、TFT、有機 EL、Si 半導体、半導体レーザ、強誘電体、DVD、磁気ヘッド、フィルタ、反射防止膜、AR フィルム



X線CT装置

株式会社島津製作所 inspeXio SMX-225CT

電子部品や軽金属系機械部品などの内部寸法測定や不良箇所の観察等を行います。X線のCTスキャンにより最大φ300×H300mmの構造体の内部構造を非破壊で撮像し、構造観察や寸法・形状計測ができます。

- 本体仕様
 X線管電圧（加速電圧）：40 ~ 225kV
 最小焦点寸法：4 μm 以下 (100kV、100 μA 時)
 搭載可能試料サイズ：φ300mm×H300mm 9kg (治具等含む)
 視野（スキャン）領域：約φ5 ~ φ200mm
 幾何学的拡大率：約 1.5 ~ 100 倍
- データ処理ソフトウェア
 3次元画像処理：VG Studio Max ・欠陥検出 ・三次元計測
 欠陥構造解析：ExFact Analysis
 リバースエンジニアリング：Point Master

